PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 04048085 A

(43) Date of publication of application: 18 . 02 . 92

(51) Int. CI

C23F 1/08

C23F 1/00

H05K 3/06

(21) Application number: 02158001

(2), 7, pp. 100001

(22) Date of filing: 15 . 06 . 90

(71) Applicant: MATSUS

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

MATSUSHITA ELECTRIC WORKS

LTD

(72) Inventor:

ISHIKAWA MASAHARU KASAI YOSHIHARU SHIRAKI HIROYUKI KANEKO JUNJI

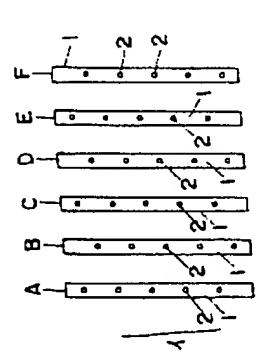
(54) ETCHING AND DEVELOPING METHOD

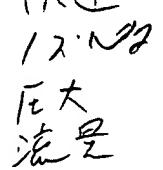
(57) Abstract:

PURPOSE: To uniformly etch the entire surface of a substrate at the time of moving the substrate placed on a conveyor and spraying a liq. chemical from a nozzle by spraying the chemical against the substrate strongly or in large amt.

CONSTITUTION: A substrate 4 is placed on the conveyor of an etching or developing device, moved while injecting a liq. chemical from a nozzle 2, etched or developed. In this case, the distance between the spraying port of the nozzle 2 and the surface of the substrate 4 is decreased on the upper surface side of the conveyor as the nozzle approaches the center from the end to the direction orthogonal to the traveling direction of the conveyor, the distribution density of the nozzles is enhanced, the spraying pressure of the nozzle 2 is increased, or the nozzle 2 having a high flow rate is used to spray the chemical against the substrate strongly or in large amt., and the entire surface of the substrate is uniformly etched or developed.







19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A)

平4-48085

®int.Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

個公開 平成4年(1992)2月18日

C 23 F 1/08 1/00 3/06 H 05 K

103 101

7179-4K 7179-4K 6921-4E 6921-4E

> 未請求 請求項の数 2 (全7頁) 審査請求

エッチング並びに現像方法 日発明の名称

> 平2-158001 ②特

QG

平2(1990)6月15日 ②出 頭

正 冶 @発 明 者 - [1] 石 与 志 冶 @発 明 笠 井 者 啓 之 @発 白 木 明 者

大阪府門真市大字門真1048番地 大阪府門真市大字門真1048番地

大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内 松下電工株式会社内 松下電工株式会社内 松下電工株式会社内

子 醇 冶 仍発 明 者 兼 松下電工株式会社 创出 頣 人

大阪府門真市大字門真1048番地

大阪府門真市大字門真1048番地

外2名 弁理士 石田 長七 倒代 理 人

明相書

1. 発明の名称

エッチング並びに現像方法

2. 特許請求の範囲

[1]エッチング装置または原像装置の搬送コン ベアに基板を載せてノズルから薬液を噴霧しなが、 ら基板を移動してエッチングまたは現像をする方 法において、豊送コンペアの上面側では搬送コン ベアの駆動方向と直交する方向の蟾部から中央部 に近付く程、ノズルのスプレーロと基板表面との 距離を短くしたり、ノズル分布密度を高くしたり、 ノズルのスプレー圧力を大きくしたり、滾畳の大 さいノズルを使用したりして累液が強く或は多量。 に基板に当たる条件で噴霰することを符徴とする。 エッチング並びに現像方法。

[2]エッチング装置または現像装置の撤送コン ペアに基収を取せてノズルから累放を噴霧しなが ら盖板を移動してエッチングまたは現像をする方 法において、撤送コンベアの下面値では撤送コン ベアの駆動方向と直交する方向の類部から中央部 に近付く程、ノズルのスプレーロと基何表面との 距離を長くしたり、ノズル分布密度を低くしたり、 ノズルのスプレー圧力を小さくしたり、流量の小 さいノズルを使用したりして東液が弱く或は少量 で基板に当たる条件で横霧することを特徴とする エッチング並びに現伍方法。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は印刷配線板等で累液喷霧によりエッチ ングする方法並びに現像する方法(現像について はエッチングと同様に適用できるが、以下説明を 省略して主にエッチングについて述べる)に関す るものである。

[従来の技術]

一般に印刷配盤板等のエッチングでは、特開昭 49-44944号公報に見られるように、承液 を噴霧する職、ノズル配管を想動させて均一なエッ チングを実現しようとしている。つまりノズル配 管の振動により差板(生産物)上に滞留する老化

した顕液を新しい顕液と交換して均一なエッチン グを試みている。第11図(a)(b)はエッチング状 鬼を示し、1はノズル配管、2はノズル、3は薬 波の潜まり、4は彼エッチング物である高板、5 仕着送コンベアである。

[発明が解決しようとする展題]

しかし基氨4の上面においては、基氨4の寸法 が大きくなると、第11図(4)に示すように蓋板 4の上面に当たった薬液は基板4の表面を伝って 基板4の蟾部から落下するので、中央部は老化し た薬液が溜まりやすく、塩部は新しい薬液との液 交換が容易である。そのため端部のエッチングが、 敏速であるが、中央部のエッチングが遅く、不均 ーなエッチングになる。また薔薇4の下面におい ては、第11図(b)に示すように基板4に当たっ た薬液は蟷部からだけでなく、中央部からも自然 (重力)辖下するので、反対に蟷螂に老化した薬 液が溜まりやすく、場節のエッチングが遅く、中 央部のエッチングが歓速であるため不均一なエッ チングとなる。

①ノズルのスプレーロと基板表面との距離を知 くする.

- のノズル分布密度を高くする。
- 因ノズルのスプレー圧力を大きくする。
- ②渷葉の大きいノズルを使用する。
- 囚上記囚と囚を組み合わせる。
- ⑥上記のとのを狙み合わせる。
- これら以外の組み合わせでもよい。

また本発明エッチング並びに現像方法は、エッ ⑤'上記①'と②'を組み合わせる。 チング装置または現像装置の撤送コンペアに基板 を載せてノズルから薬液を噴霧しながら基板を移っ 動してエッチングまたは現像をする方法において、 **搬送コンペアの下面側では搬送コンペアの窓動方** 向と直交する方向の端部から中央部に近付く程、 ノズルのスプレーロと基収表面との距離を長くし たり、ノズル分布密度を低くしたり、ノズルのス アレー圧力を小さくしたり、流量の小さいノズル を使用したりして薬液が弱く或は少量で基板に当 たる条件で喉咙することを 強とすることも好せ しい。

本発明は叙述の点に鑑みてなされたものであっ て、本発明の目的とするところは基収全面に亘っ て均一なエッチングや現象ができるエッチング炎 びに現伍方法を提供するにある。

【悪魔を解決するための手段】

上記目的を達成するため本発明エッチング並び に現像方法は、エッチング装置または現像装置の 第しながら基板を移動してエッチングまたは現像 をする方法において、撤送コンベアの上面便では 搬送コンペアの駆動方向と直交する方向の幅部か ら中央部に近付く程、ノズルのスプレーロと 碁板 表面との距離を短くしたり、ノズル分布密度を高 くしたり、ノズルのスプレー圧力を大きくしたり、 液量の大きいノズルを使用したりして蒸液が強く 並は多量に基度に当たる条件で噴霧することを特 徴とする。

差板の上面側において楽液が強く成は多量に萎 板に当たるようにする手段を列挙すると次の通り である.

基板の下面側において承液が弱く収は少量で基 板に当たるようにする手段を列挙する次の通りで ある.

- ① ' ノズルのスプレーロと芸収表面との距離を 長くする。
- ②′ノズル分布密度を低くする。
- ◎′ ノズルのスプレー圧力を小さくする。
- ② ′ 流量の小さいノズルを使用する。
- の、上記の、との、を組み合わせる。

〔作用〕

基板の上面では増部に比べて中央部に素液を強 くあるいは多量に当てて中央部の薬液の交換を促 激し、基板の上面全面に且って均一にエッチング や現像ができる。また基板の下面では中央部に比 べて増都の素液の交換を促進し、基板の下面全面 に亘って均一にエッチングや現像ができる。

〔実施例〕

衰施剂1

これは差板4の上面側の条件を印とし、高板4

の下面側の条件。〇 ' としたものである。つまり、 基収4の上面側では塩部から中央部に近付く程、 ノズル2のスプレーロと基収4表面との距離を短 くしてあり、基収4の下面側では雌部から中央部 に近付く程、ノズル2のスプレーロと基収4表面 との距離を長くしてある。第1回に示す複数面の ノズル2を有するノズル配管1は撤送コンペア5 の撤送方向(第1回矢印イ方向)を向いており、 ノズル配管1を複数列(本実施例の場合符号A乃 至Fに示す6列)並べてある。

表収4の上面側では符号A、Fで示すノズル配管1のノズル2の長さは第2回(4)に示すように短く、ノズル2のスプレーロと基板4の表面との面の距離がℓ、(例えば160mm) と長くなっている。符号B、Eで示すノズル配管1のノズル2の長さは第2回(b)に示すように中間の長さになっており、ノズル2のスプレーロと基板4表面との距離がℓ2(例えば120mm)と中間の長さになっている。このノズル2は中間の長さのノズル延長用バイア6aを介して設けてある。符号C、Dに

示すノズル配管1のノズル2の長さは第2回(c) に示すように長くなっており、ノズル2のスプレ ーロと基収4表面との距離がより(例えば80mm) と短くなっている。このノズル2は長いノズル延 長パイプ66を介して設けてある。

また基板4の下面側では符号A、Fに示すノズル包管1では第2図(e)に示すようにノズル2と 基板4表面との距離がℓ2と短く、符号B、Eで示すノズル配管1では第2図(b)に示すようにノズル2と基板4の表面との距離がℓ2と中間の長さで、符号C、Dに示すノズル配管1では第2図(a)に示すようにノズル2と基板4表面との距離はℓ1と長い。

しかして基収4の上面側では地部から中央に近付く程、ノズル2から暗霧する薬液が強く当たり、 基収4の下面側では中央から地部に近付く程、ノ ズル2から喉部する薬液が強く当たり、基収4の 上面側でも下面側でも老化した薬液と新しい薬液 との交換が均一に行われて全面に直って均一にエッチングが行われる。

<u>実施例 2</u>

これは基板4の上面側の条件を包とし、基板4の下面側の条件を包'としたものである。つまり、 碁板4の上面側では撮影から中央部に近付く程、 ノズル2の分布密度を高くしてあり、碁板4の下 面側では塩部から中央部に近付く程、ノズル2の 分布密度を低くしてある。

 ル2を設けるピッチが中間で、符号C.Dで示す ノズル配管1のノズル2を設けるピッチが小さい。

第4回は基板4の下面側のノズル2の配置を示すものである。この場合符号Aのノズル配管1と符号Eのノズル配管1との間隔w」、や符号Eのノズル配管1と符号Cのノズル配管1と符号Cのノズル配管1と符号Dのノズル配管1との間隔w」、が映く、符号Bのノズル配管1と符号Dのノズル配管1と符号Dのノズル配管1と符号Dのノズル配管1と符号Dのノズル配管1との間隔w」、が中間で、符号Cのノズル配管1と符号Dのノズル配管1との間隔w」、が広い。具体的にはw」、は80mm、w」、は120mm、w」、は150mmである。また符号A、Fで示すノズル配管1のノズル2を設けるピッチが小さく、符号B、Eに示すノズル配管1のノズル2を設けるピッチが中間で、符号C、Dで示すノズル配管1のノズル2を設けるピッチが大きい。

しかして基収4の上面側では増部から中央に近付く程、ノズル2から噴露する裏徴が集中して当たり、基収4の下回側では中央から眺部に近付く

程、ノズル2から噴霧する裏液が集中して当たり、 当収4の上回倒でも下回倒でも老化した裏液と新 しい裏液との交換が与一に行われて全面に亘って カーにエッチングが行われる。

突旋例3

これは基板4の上面側の条件を図とし、基板4の下面側の条件を図'としたものである。つまり、 基板4の上面側では端部から中央部に近付く程、 ノズル2のスプレー圧力を大きくしてあり、基板 4の下面側では端部から中央部に近付く程、ノズ ル2のスプレー圧力を小さくしてある。

基板4の上面側では第5図の符号で、Dに示す ノズル配管1のノズル2からのスプレー圧力は高 く、例えば2Kg/cmgである。符号B.Eに 示すノズル配管1のノズル2からのスプレー圧力 は中間で、例えば1.5Kg/cmgである。符 号A.Fで示すノズル配管1のノズル2からのス プレー圧力は低く、例えば1Kg/cmgである。

基板4の下面では符号A.Fで示すノズル配管 1のノズル2のスプレー圧力が高く、例えば2K s/cm*である。符号B,Eで示すノズル配管 1のノズル2のスプレー圧力が中間で、例えば1、 8 K s/cm*である。符号C,Dに示すノズル 配管1のノズル2のスプレー圧力が低く、例えば 1、5 K s/cm*である。

しかして基板4の上面側では端部から中央に近付く程、ノズル2から噴霧する薬液が強く当たり、 基板4の下面側では中央から端部に近付く程、ノ ズル2から噴霧する薬液が強く当たり、基板4の 上面側でも下面側でも老化した薬液と新しい薬液 との交換が均一に行われて全面に直って均一にエッチングが行われる。

突施例4

これは基収4の上面側の条件を①とし、基収4の下面側の条件を①'としたものである。つまり、 基収4の上面側では塩部から中央部に近付く程、 液量の大きいノズル2を使用しており、基収4の 下面側では増部から中央部に近付く程、液量の小 さいノズル2を使用している。

基製4の上面側では第6図の∕符号C。 D に示す

ノズル配管1のノズル2の流量が多く、例えば8 ℓ/minである。符号B、Eに示すノズル配管 1のノズル2の流量が中間で、例えば6ℓ/mi nである。符号A、Fで示すノズル配管1のノズ ル2の流量は少なく、例えば4ℓ/minである。

差収4の下面側では符号A、Fに示すノズル配 ノズル2のスプレーロと基板4表面との距離を見 管1のノズル2の流量は多く、例えば8 L/mi くすると共にノズル2の分布密度を低くしている nである。符号B、Eで示すノズル配管1のノズ 基収4の上面側では第7回(a)に示すように増 ル2の流量は中間で、例えば7 L/minである。 都から中央部に近付く程、ノズル配管1の間隔が 符号C、Dで示すノズル配管1のノズル2の流量 Wi、Wi、Wiと小さくなっている。具体的には は少なく、例えば6 L/minである。 Wiは150mm、Wiは100mm、Wiは50

しかして基板4の上面値では程部から中央に近付く程、ノズル2から噴霧する薬液が多く当たり、基板4の下面値では中央から増部に近付く程、ノズル2から噴霧する薬液が多く当たり、基板4の上面値でも下面値でも老化した薬液と新しい薬液との交換が均一に行われて全面に互って均一にエッチングが行われる。

<u>集集例 5</u>

これは基板4の上面側の条件を⑤とし、基板4 1のノズル2のスプレーロと基板4との距離は第

の下面側の条件を⑤'としたものである。つまり、 差板4の上面側では端部から中央部に近付く程、 ノズル2のスプレーロと基板4表面との距離を短 くすると共にノズル2の分布密度を高くしており、 差板4の下面側では端部から中央部に近付く程、 ノズル2のスプレーロと基板4表面との距離を長くすると共にノズル2の分布密度を低くしている。

基板4の上面側では第7図(a)に示すように場から中央部に近付く程、ノズル配管1の間隔がwi,wi,wiと小さくなっている。具体的にはwiは150mm、wiは100mm、Wiは50mmである。また場部のノズル配管1から中央部のノズル配管1に向けてノズル2を設けるピッチが小さくなっている。しかも符号A、Fに示すノズル配管1のノズル2のスプレーロと基板4との間の距離は第8図(a)に示すようにℓ」と乗く、符号B、Eに示すノズル配管1のノズル2のスプレーロと基板4との距離は第8図(b)に示すようにℓ」と中間の長さで、符号C、Dに示すノズル配管1のノズル2のスプレーロと基板4との距離は第1のノズル2のスプレーロと基位4との距離は第1のノズル2のスプレーロと基位4との距離は第1のノズル2のスプレーロと基位4との距離は第1のノズル2のスプレーロと基位4との距離は第1のノズル2のスプレーロと基位4との距離は第1のノズル2のスプレーロと基位4との距離は第

8四(e)に示すようにむと知い。具体的にはむが 150mm、たが100mm、たが90mmである。

著板4の下面側では第7図(b)に示すように細部から中央部に近付く程、ノズル配管1の間隔がwin、win、win、win、win、win、win、win、win、ta 0 mm、win、ta 0 mm、win、ta 1 0 mm、win、ta 1 0 mm、win、ta 1 0 mm、win、ta 1 0 mm、ta 2 0 mm、ta 3 0 mm ta 4 0 mm ta 4 0 mm ta 4 0 mm ta 4 0 mm ta 3 0 mm ta 4 0 mm ta 4 0 mm ta 4 0 mm ta 5 0 mm ta 5 0 mm ta 4 0 mm ta 6 0 m

しかして基板4の上面側では増都から中央に近付く程、ノズル2から戦弊する単液が強く当たると共に集中して当たり、基板4の下面側では中央

うに見と中国の長さで、符号C.Dに示すノズル 配管1のノズル2のスプレーロと基収4との距離 は第10図(a)に示すように見っと短い。具体的に は見が150mm。見っが120mm、見っが90m mである。しかも符号A、Fに示すノズル配管1 のノズル2からのスプレー圧力は小さく、具体的 には1Ks/cm³であり、符号B。Eに示すノ ズル配管1のノズル2からのスプレー圧力は中間 で、具体的には1・2Ks/cm³であり、符号 C,Dに示すノズル配管1のノズル2からのスプレー圧力はすく、具体的には1・5Ks/cm³ レー圧力は高く、具体的には1・5Ks/cm³

基板4の下層器では第9国の符号で、Dに示す ノズル配管1のノズル2のスプレーロと基板4と の間の距離は第10国(a)に示すように4.と長く、 符号B、Eに示すノズル配管1のノズル2のスプレーロと基板4との距離は第10国(b)に示すように4.と中間の長さで、符号A、Fに示すノズル 配管1のノズル2のスプレーロと基板4との距離 は第10国(a)に示すように4.と短い、しかも符 から塩部に近付く程、ノズル 2 から噴霧する薬液が強く当たると共に集中して当たり、基板 4 の上面側でも下面側でも老化した薬液と新しい薬液との交換が均一に行われて全面に互って均一にエッチングが行われる。

突旋例 6

これは基収4の上面側の条件を即とし、基収4の下面側の条件を即「としたものである。つまり、基収4の上面側では増部から中央部に近付く程、ノズル2のスプレーロと基収4表面との距離を拠くすると共にノズル2のスプレー圧力を大きくしており、基収4の下面側では増部から中央部に近付く程、ノズル2のスプレーロと基収4表面との距離を長くすると共にノズル2のスプレー圧力を小さくしている。

基板4の上面側では第9図の符号A., Fに示す ノズル配管1のノズル2のスプレー口と基板4.と の間の配能は第10図(a)に示すようにむと長く、 符号B, Eに示すノズル配管1のノズル2のスプ レーロと基板4との距離は第10図(b)に示すよ

号で、Dに示すノズル配管1のノズル2からのスプレー圧力は小さく、具体的には1Kg/cm:であり、符号B、Eに示すノズル配管1のノズル2からのスプレー圧力は中間で、具体的には1.1Kg/cm²であり、符号A、Fに示すノズル配管1のノズル2からのスプレー圧力は高く、具体的には1.2Kg/cm²である。

しかして基板4の上面側では増部から中央に近付く程、ノズル2から噴霧する素液が強く当たり、基板4の下面側では中央から増部に近付く程、ノズル2から噴霧する薬液が強く当たり、基板4の上面側でも下面側でも老化した薬液と新しい薬液との交換が均一に行われて全面に互って均一にエッチングが行われる。

[発明の効果]

本売明は叙述の知く製送コンペアの上面側では 製送コンペアの影響方向と高交する方向の地部か ら中央部に近付く程、ノズルのスプレーロと革気 表面との距離を短くしたり、ノズル分布密度を高 くしたり、ノズルのスプレー圧力を大きくしたり、 複量の大きいノズルを使用したりして緊液が致く 或は多量に基板に当たる条件で噴霧するので、差 板の上面の中央部での緊液の交換の促進がされ、 基板の上面の全面に互って均一な実液の交換がさ れて基板上面でのエッチングや現像が均一に行わ れるものである。

4.図面の簡単な説明

第1団は本考案の実施例1を説明する平面図、 第2団(a)(b)(c)は同上のノズルのスプレーロと

基板の距離を説明する正面図、第3図は同上の実 施例2の基板上面側のノズル配置を示す平面図、 第4図は同上の実施例2の基板下面側のノズル配 置を示す平面図、第5図は同上の実施例3を製明 する平面図、第6図は何上の実施例4を説明する 平面図、第7図(a)は同上の実施例5の基板上面 個のノズル配置を示す平面図、第7図(b)は何上 の実施例5の基板下面側のノズル配置を示す平面 図、第8図(a)(b)(c)は同上の実施例5のノズル のスプレーロと基板の距離を説明する正面図、第 9国は同上の実施例6を説明する平面図、第10 図(a)(b)(c)は阿上の実施例6のノズルのスプレ 一口と基板の距離を説明する正面図、第11図(m) (b)は従来例の問題を説明する断面図であって、 1はノズル配管、2はノズル、4は恙板、5は挫 送コンベアである。

代理人 弁理士 石 田 長 七

